

	<p>SIS606BDN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIS606BDN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212</p>
	<p>Datenblätter:  SIS606BDN-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS606BDN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.4 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS606BDN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1470pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 9.4A (Ta), 35.3A (Tc) 3.7W (Ta), 52W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Ta), 35.3A (Tc)

SIS606BDN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS606BDN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS606BDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS606BDN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS620A2FX SIS SIS620A2FX SIS</p>	 <p>SIS5598B SIS SIS BGA</p>	 <p>SIS6202 SIS SIS QFP</p>	 <p>SIS612EDNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 50A SMT</p>
 <p>SIS5595 SIS SIS QFP208</p>	 <p>SIS6205 SIS SIS O-NEW Q</p>	 <p>SIS60020F00A1 EPSON EPSON QFP</p>	 <p>SIS5598 SIS SIS BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS606BDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS606BDN-T1-GE3 Datenblatt	SIS606BDN-T1-GE3-Datenblätter	SIS606BDN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIS606BDN-T1-GE3 Electronic	SIS606BDN-T1-GE3-Komponenten	SIS606BDN-T1-GE3-Verteiler	SIS606BDN-T1-GE3-Bild	SIS606BDN-T1-GE3-Teil
SIS606BDN-T1-GE3 Preis	SIS606BDN-T1-GE3 Hersteller	SIS606BDN-T1-GE3 Bild	SIS606BDN-T1-GE3 Aktie	SIS606BDN-T1-GE3 Inventar
SIS606BDN-T1-GE3 Neu	SIS606BDN-T1-GE3 Original	SIS606BDN-T1-GE3 garantiert	SIS606BDN-T1-GE3 RFQ	SIS606BDN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited